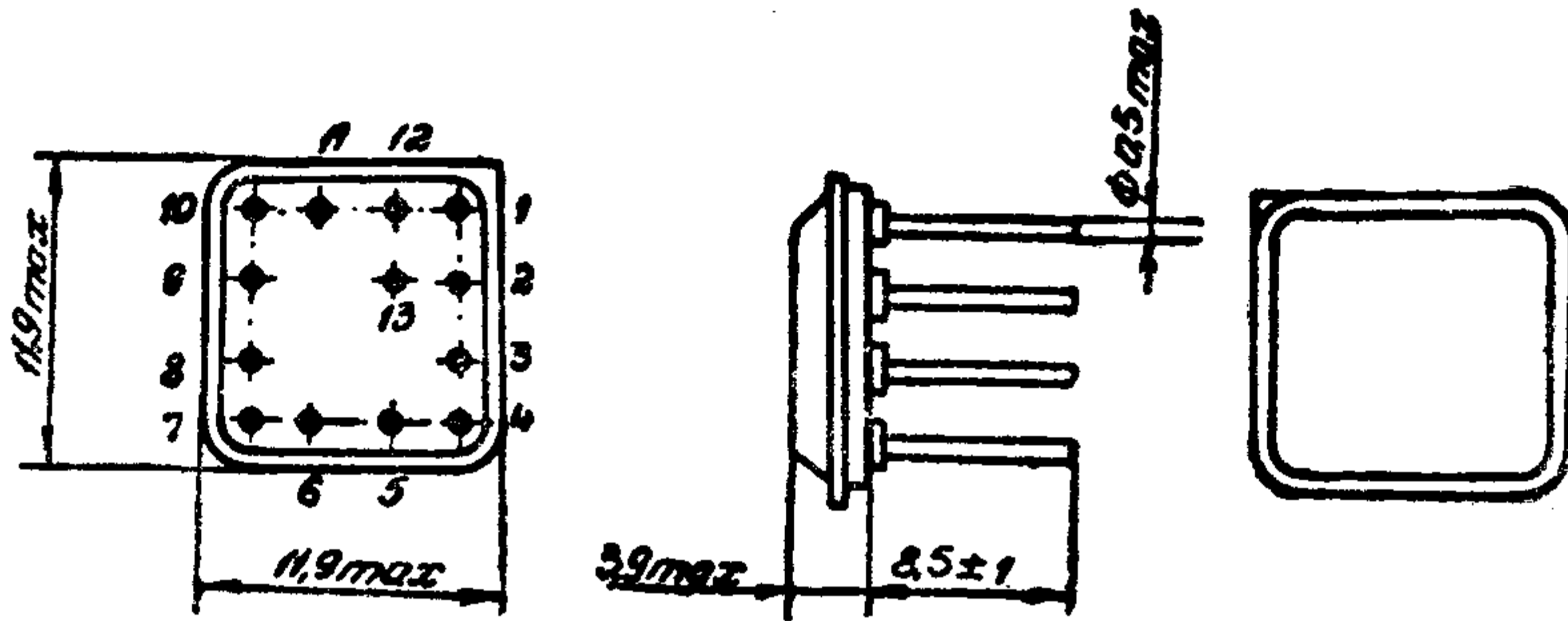


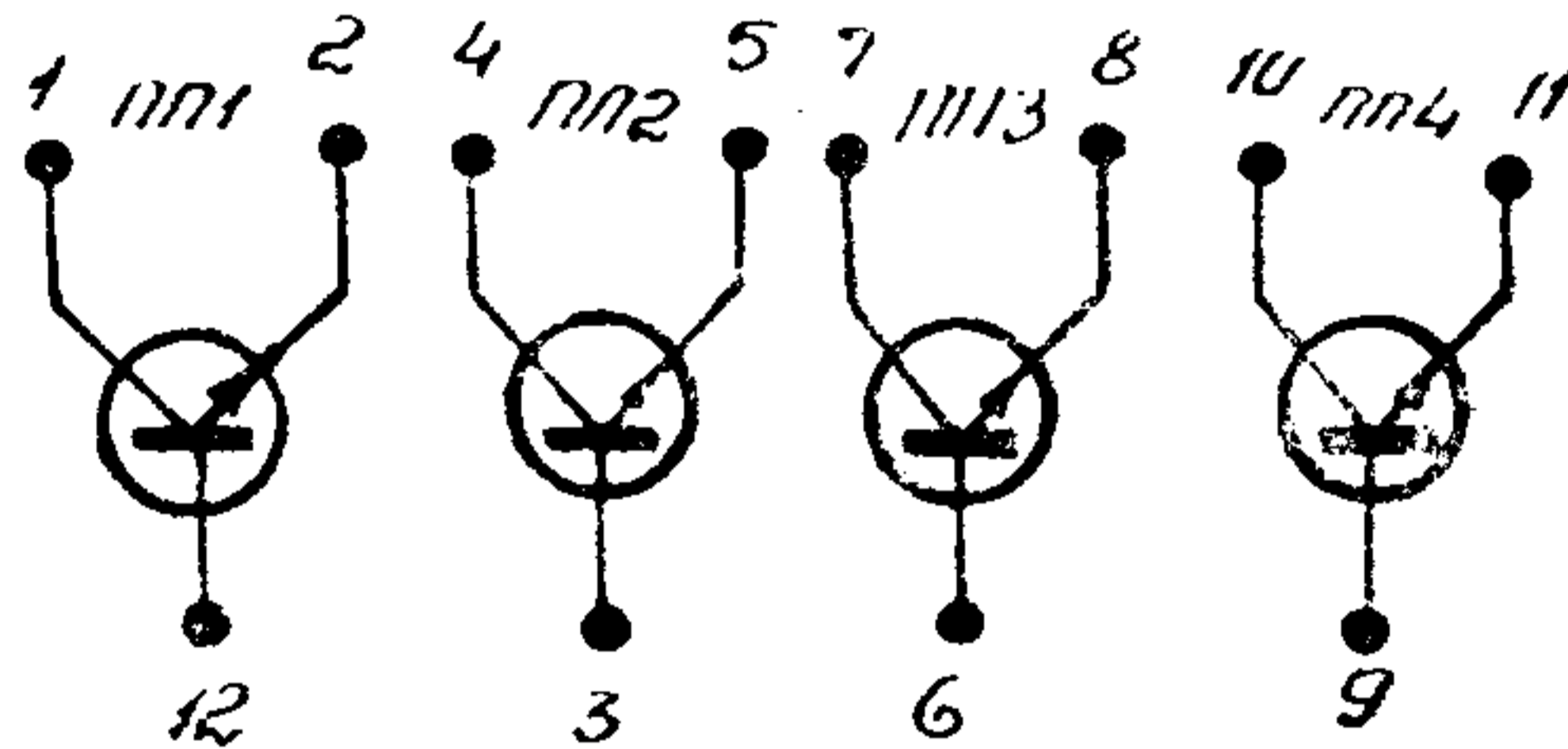
Серия 217	МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ГИБРИДНЫЕ	ЩИЗ.456.004 П
Тип 2НТ172	ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА Паспорт	Редакция 1—69

Габаритный чертеж микросхемы



Вес микросхемы не более 1,5 г

Принципиальная электрическая схема



- Вариант I ПП1 — ПП4 — транзистор кремниевый 2Т318Д или 2Т318Б
- Вариант II ПП1 — ПП4 — транзистор кремниевый 2Т333Д или 2Т333Б
- Вариант II обозначается треугольником цвета маркировки

Основные технические характеристики микросхемы 2НТ172

1. Основные электрические параметры (при $T = +20^\circ \pm 5^\circ \text{C}$)

Обратный ток коллектора	$I_{ка} \leq 1,0 \text{ мка}$
Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения	$U_{кэн} \leq 0,33 \text{ в}$
Статический коэффициент передачи тока	$V_{ст} = 50 - 150$
Время рассасывания	$\tau_p \leq 25 \text{ нсек}$

2. Предельно-допустимые эксплуатационные параметры микросхем при

температуре окружающей среды минус $60^\circ \text{C} - +70^\circ \text{C}$

Напряжение коллектор-базы	10 в
Напряжение коллектор эмиттер	10 в
Напряжение эмиттер-база	3,5 в
Ток коллектора	20 ма
Импульсный ток при скважности 2	45 ма
Максимальная мощность рассеяния микросхемой при работе 1, 2, 3, 4-х транзисторов	$P_1 = 20 \text{ мВт}$ $P_2 = 40 \text{ мВт}$ $P_3 = 60 \text{ мВт}$ $P_4 = 80 \text{ мВт}$

3. Рекомендации по установке микросхем

При монтаже микросхемы устанавливаются на печатные платы с зазором 1 — 1,5 мм.

Пайку производить одножальным паяльником с температурой жала не выше 260°C при длительности непрерывного касания паяльником вывода микросхемы не более 3 сек. С промежутком времени между двумя касаниями не менее 3 сек. Интервал времени между пайками соседних выводов микросхем должен быть не менее 5 сек.

4. Предельно-допустимые условия эксплуатации

Температура окружающей среды от -60°C до $+70^\circ \text{C}$

Относительная влажность воздуха 95—98% при $T = +40^\circ \pm 2^\circ \text{C}$

Атмосферное давление от 5 мм рт. ст. до 3 ата

Вибрация с ускорением до 40 g в диапазоне частот от 5 гц до 5 000 гц

Многokратные удары с ускорением до 150 g

Одиночные удары с ускорением до 1 000 g

Линейные (центробежные) ускорения до 150 g

5. Время гарантийной наработки — 10 000 часов

6. Срок хранения — 12 лет

7. Гарантии предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех поставляемых микросхем требованиям ОТУ и ЧТУ и производит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим прейскурантам), если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют соответствующим требованиям ОТУ и ЧТУ при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости этих микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

8. Гарантии исчисляются со дня приемки их ОТК или представителем заказчика

Представитель ОТК



Представитель заказчика

10. V. 72

СОДЕРЖИТ ДРАГМЕТАЛЛЫ

Золото 13.95 мг
Серебро 0.045 мг

I ВАРИАНТ

СОДЕРЖИТ ДРАГМЕТАЛЛЫ

Золото 13.04 мг
Серебро 0.057 мг

II ВАРИАНТ